

## H03 電子回路

H03B 振動の発生，直接のまたは周波数変換による振動の発生，スイッチング動作を行なわない能動素子を用いた回路による振動の発生；このような回路による雑音の発生（電気機械的手段による楽器に特別に適合する発振器 G 1 0 H；メーザまたはレーザ H 0 1 S；プラズマにおける振動の発生 H 0 5 H）

## サブクラス内の索引

周波数変換によらない発生

増巾と帰還による手段；負性抵抗 ..... 5/00;7/00

電子走行時間による手段；電子ビーム管 ..... 9/00;13/00

衝撃励振によるもの；ホール効果；放射源と検出器の組み合わせ ..... 11/00;15/00;17/00

周波数変換による発生

信号の逡倍または逡降によるもの ..... 19/00

非変調信号の結合によるもの ..... 21/00

発生した振動の特殊性

周波数範囲の掃引；多重周波数；多重位相；雑音 ..... 23/00;25/00;27/00;29/00

その他の発生方法 ..... 28/00

細部 ..... 1/00

1/00 細部

1/02 ・電力発振器，例．加熱用発振器，の構造上の細部（電磁界による加熱のための発振器 H 0 5 B 6 / 0 0）

1/04 ・不要発振，例．高調波，の低減

5/00 出力から入力への再生帰還による増幅器を用いた振動の発生（H 0 3 B 9 / 0 0，H 0 3 B 1 5 / 0 0 が優先）

5/02 ・細部

5/04 ・物理的な値，例．電源，負荷，温度，の変化を補償するための発振器の変形

5/06 ・発振の起動を確実にするための発振器の変形（発振器の起動 H 0 3 L 3 / 0 0）

5/08 ・周波数決定素子が集中定数インダクタンスと集中定数キャパシタンスとからなるもの

5/10 ・増幅器の能動素子が真空管であるもの（H 0 3 B 5 / 1 4 が優先）

5/12 ・増幅器の能動素子が半導体装置であるもの（H 0 3 B 5 / 1 4，H 0 3 B 7 / 0 6 が優先）

5/14 ・周波数決定素子がブリッジ回路を経て信号が伝送される閉ループに結合されているもの

5/16 ・増幅器の能動素子が真空管であるもの

5/18 ・周波数決定素子が分布定数インダクタン

スと分布定数キャパシタンスとからなるもの

5/20 ・周波数決定素子が抵抗とキャパシタンスまたはインダクタンスのいずれか一方とからなるもの，例．位相発振器

5/22 ・増幅器の能動素子が真空管であるもの（H 0 3 B 5 / 2 6 が優先）

5/24 ・増幅器の能動素子が半導体装置であるもの（H 0 3 B 5 / 2 6 が優先）

5/26 ・周波数決定素子が，信号が伝送される閉ループ中のブリッジ回路の一部であるもの；周波数決定素子がブリッジ回路を経て，上記閉ループに結合されているもの，例．ウイーンブリッジ発振器，並列 T 型発振器

5/28 ・増幅器の能動素子が真空管であるもの

5/30 ・周波数決定素子が電気機械的振動子であるもの

5/32 ・圧電気振動子であるもの

5/34 ・増幅器の能動素子が真空管であるもの（H 0 3 B 5 / 3 8 が優先）

5/36 ・増幅器の能動素子が半導体装置であるもの（H 0 3 B 5 / 3 8 が優先）

5/38 ・周波数決定素子がブリッジ回路を経て信号が伝送される閉ループに結合されているもの

5/40 ・磁わい振動子であるもの（H 0 3 B 5 / 4 2 が優先）

5/42 ・周波数決定素子がブリッジ回路を経て，信号が伝送される閉ループに結合されているもの

7/00 2つの電極間に負性抵抗をもつ能動素子を用いた振動の発生（H 0 3 B 9 / 0 0 が優先）

7/02 ・集中定数インダクタンスと集中定数キャパシタンスとからなる周波数決定素子を有するもの

7/04 ・能動素子が真空管であるもの

7/06 ・能動素子が半導体装置であるもの

7/08 ・トンネルダイオードであるもの

7/10 ・能動素子がガス放電管またはアーク放電管であるもの

7/12 ・分布定数インダクタンスと分布定数キャパシタンスとからなる周波数決定素子を有するもの

7/14 ・能動素子が半導体装置であるもの

9/00 走行時間効果を用いた振動の発生 [ 2 ]

9/01 ・電子管を用いるもの [ 2 ]

9/02 ・遅延電磁界電子管を用いるもの（クライストロンを用いるもの H 0 3 B 9 / 0 4）[ 2 ]

9/04 ・クライストロンを用いるもの [ 2 ]

## H 0 3 B

9/06	・ ・ ・ 反射型クライストロンを用いるもの [ 2 ]		の周波数の同時発生
9/08	・ ・ 進行波管を用いるもの [ 2 ]	27/00	単なる逆相関係の 2 出力ではなくて、周波数等しく位相相異なる複数個の出力を与える振動の発生
9/10	・ ・ マグネトロンを用いるもの [ 2 ]		
9/12	・ 固体装置を用いるもの、例．ガン効果装置 [ 2 ]	28/00	正弦波振動を発生するために波形の変形を含み、かつ、波形の修正による正弦波状振動の発生を含み、グループ H 0 3 B 5 / 0 0 ~ H 0 3 B 2 7 / 0 0 に含まれない方法による振動の発生（計算動作を行うためのアナログ関数発生器 G 0 6 G 7 / 2 6 ） [ 4 ]
9/14	・ ・ 分布インダクタンスとキャパシタンスとを構成する素子をも用いるもの [ 3 ]		
11/00	衝動励振同調回路を用いた振動の発生（帰還をもつもの H 0 3 B 5 / 0 0 ）		
11/02	・ スパークにより励振されるもの		
11/04	・ 断続器により励振されるもの	29/00	雑音電流および雑音電圧の発生（雑音発生器として特別に適合する固体陰極をもつガス入り電子管 H 0 1 J 1 7 / 0 0 ）
11/06	・ ・ 機械的断続器によるもの		
11/08	・ ・ 断続器が電子管であるもの		
11/10	・ ・ 断続器が半導体装置であるもの		
13/00	陰極線管中の電子ビームの偏向を用いた振動の発生		
15/00	電流磁気効果装置、例．ホール効果装置、スピントランスファ効果を用いた装置、巨大磁気抵抗を用いた装置、または超伝導効果を用いた振動の発生		
17/00	放射源と検出器とを用いた振動の発生		
19/00	別個の発生源からの信号周波数の非再生的、逡倍または逡降による振動の発生		
19/03	・ 非線形インダクタンスを用いるもの [ 3 ]		
19/05	・ 非線形キャパシタンス、例．バラクタダイオード、を用いるもの [ 3 ]		
19/06	・ 2 以上の電極をもつ電子管または半導体装置によるもの		
19/08	・ ・ 電子管によるもの		
19/10	・ ・ ・ 逡倍のみを用いるもの		
19/12	・ ・ ・ 逡降のみを用いるもの		
19/14	・ ・ 半導体装置によるもの		
19/16	・ 無制御の整流装置を用いるもの、例．整流ダイオードまたはショットキーダイオードを用いるもの [ 3 ]		
19/18	・ ・ 分布インダクタンスとキャパシタンスとを構成する素子をも用いるもの [ 3 ]		
19/20	・ ・ ダイオードが電荷蓄積またはエンハンスメント効果を示すもの [ 3 ]		
21/00	相異なる周波数の非変調信号を結合することによる振動の発生（ H 0 3 B 1 9 / 0 0 が優先 ） [ 3 ]		
21/01	・ 相異なる周波数の非変調信号間のビートによるもの [ 3 ]		
21/02	・ ・ 複数回のビートによるもの、例．周波数合成用 [ 3 ]		
21/04	・ ・ いくつかの似かよった段を用いるもの [ 3 ]		
23/00	所定周波数範囲を周期的に掃引する振動の発生		
25/00	1 個の自励発振器による、相異なる複数個		